



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-053407

(43)Date of publication of application: 07.03.1991

(51)Int.CI.

H01B 3/12 C04B 35/46

(21)Application number: 01-187892

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.07.1989

(72)Inventor: KURAHASHI WATARU

KURAMITSU HIDENORI

IINO TAKESHI KUSAKABE KENJI

(54) DIELECTRIC PORCELAIN COMPOSITE

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase dielectric constant, insulation resistance and dielectric breakdown voltage while improving satisfactoriness Q and reducing temperature coefficient by making a specific composite to contain V2O5 as a secondary component.

CONSTITUTION: A composite having the range of a molar ratio, in which x to z are surrounded by the respective points a to d shown in the table 1 as a main component when the general formula is expressed as xSrO-yCaO-zTiO2 (provided that x+y+z=1.000) is made to contain V2O5 0.1 to 5.0wt.% as an auxiliary component. Thereby, a dielectric porcelain has a high dielectric constant, insulation resistance and insulation breakdown voltage, being excellent in goodness Q, having a small temperature coefficient while lowering a baking temperature by adding oxides of manganese, chrome, iron, nickel, cobalt and silicon, can be obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office



⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-53407

Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)3月7日

H 01 B 3/12 C 04 B 35/46 304 E 9059-5G 7412-4G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

図発明の名称

誘電体磁器組成物

願 平1-187892 ②特

頤 平1(1989)7月20日 匈出

⑫発 明 榹 者 倉 ⑫発 明 者 倉 光 紀. 猛

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 松下電器産業株式会社内

@発 明 者 飯 野 @発 明 者 日下部 健 治

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社 勿出 願 人 個代 理 人 弁理士 栗野 重章

外1名

1、発明の名称

铁電体磁器組成物

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 一般式

xSrO-yCaO-zTiOzと表わした時 が以下に表わす各点a、b、c、dで囲まれる モル比の範囲を主成分とする組成物に対し、副 成分として V2 O5 O.1~5.0 重量%を含有す ることを特徴とする誘電体磁器組成物。

	х	у	2
a	0.27	0.21	0.52
b	0.31	0.20	0.49
С	0.33	0.16	0.51
d	0.29	0.17	0.54

(2) マンガン、クロム、鉄、ニッケル、コパル ト及びケイ器の酸化物からなる群の中から選 はれた少なくとも一種を、それぞれMnO2, Cr2O1, FeO. NiO, CoO及びSiO1 に換算して、主成分の0.05~1.00重量% 添加合有したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の誘電体磁器組成物。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は誘電車、絶縁抵抗及び絶縁破壊電圧が 高く、良好度Qにすぐれ、かつ温度係数の小さい 誘電体磁器組成物に関するものである。

従来の技術

従来から誘電体磁器組成物として下記のような 系が知られている。

- · La, O1 2 Ti O2 Ca Ti O1 2 Mg O - T i O 2 系
- T i O2 B a T i O3 B i 2 O3 L a 2 O3 系
- · BaTiO:系
- · Sr Ti O 3系
- · CaTIO,系
- · MgTiO1系
- · Sr Ti Oı Ca Ti Oı系 発明が解決しようとする課題

特丽平3-53407(2)

Staffell mag

しかし、これらの一つの組成物が高い誘電車、 小さい温度係数、及びすぐれた良好度Qの全てを 満足することは不可能である。

さらに、Bi₂O₁を含んでいるものは、積層セラミックコンデンサの内部電極として、Pdを用いることができないという護期があった。

本発明は誘電率、 絶縁抵抗及び絶縁破壊電圧が 高く、 良好度 Q に すぐれ、かつ温度係数の小さい 誘電体磁器を得ることを目的とするものである。

課題を解決するための手段

この課題を解決するために本発明の誘電体磁器組成物は、一般式 \times S r O - y C a O - 2 T i O $_2$ と扱わした時(ただし、 \times + y + z = 1.00)、 \times 、y、z が以下に表わす各点 a、b、c、d で囲まれるモル比の範囲を主成分とする組成物に対し、副成分として \times 2 O $_5$ O

(以下 余白)

係数が - (マイナス)側に大きくなり、実用的でなくなる。さらに、本発明は上記主成分と副成分に対し、マンガン、クロム、鉄、ニッケル、コパルト及びケイ素の酸化物からなる群の中から選ばれた少なくとも「種類を、それぞれM n O 2、

CreO2, FeO. NiO, CoO, 及びSiO1 に換算して、上記主成分の0.05~1.00重量 %添加せしめた構成とすることができる。これら の添加物は、磁器の旋結性を向上させる効果を有 しているが、その添加量が0.05重量%未満で は添加効果はなく、一方1.00重量%を超える と誘電電が低下する。

作用

本発明の誘電体磁器組成物により、誘電率、絶縁抵抗及び絶縁破壊電圧が高く、良好度Qにすぐれ、かつ温度係数の小さい誘電体磁器組成物を得ることができる。

実施例

以下、本発明を具体的実施例により説明する。 (実施例1)

	×	у	2
·· a ·	10 (2 7 ···)	0.21	0.52
b	0.31	0.20	0.49
С	0.33	0.16	0.51
d	0.29	0.17	0.54

第1図は本発明にかかる組成物の主成分の組成範囲を示す三角図であり、主成分の組成範囲を限定した理由を図を参照しながら設明する。すなわち、A 領域と C 領域では温度係数が - (マイナス)側に大きくなり過ぎて、実用的でなくなる。また、B 領域と D 領域では焼結困難となり、誘電車、良好度 Q、絶縁抵抗が低下する。

また、第2図(a)~(e)は第1図に示す主成分に対し、別成分としてのV₂〇s 含有の効果を示すグラフであり、V₂〇s 含有範囲を限定した理由をグラフを参照しながら説明する。第2図(a)~(e)に示すようにV₂〇s を含有することにより、 絶縁破壊電圧が増大する効果を有し、 その含有量が主成分に対し0、1 重量%未満では含有効果がなく、一方5、0 強量%を超えると良好度Qが低下し、温度

出発原料には化学的に高純度のS г С О 3. CaCO1, TiO1, ZrO2及びV1O5粉末 を - 下記の第1 表に示す組成になるように拝量し、め このうボールを備えたゴム内張りしたボールミルに 純水とともに入れ、20時間、湿式混合した。次 いで、この混合物を脱水乾燥後、1100℃で2 時間仮焼成した。次に、租粉砕後、再度、めのう ボールを備えたゴム内張りしたボールミルに純水 とともに入れ、20時間、湿式粉砕を行った。次 いで、この粉砕物を脱水乾燥した後、粉末にパイ ンダーとして渡度5%のポリピニルアルコール水 溶液を9頭量%添加して均質とした後、32メッ シュのふるいを通して監拉した。次に、監粒扮体 を金型と油圧プレスを用いて成形圧力1 ton/ cnlで直径15mm、厚みO.4mmに成形し、成形物 をZrOt物を敷いた高純度のアルミナ匣針中に 入れ、空気中において下記の第1表に示す温度で 2時間焼成し、第1表に示す配合組成の誘電体磁 器を得た。

これらの試料の電気特性は、試料の両面に銀電極

特别平3-53407(3)

を焼き付け、誘電率、良好度Q、温度係数はYHP 社製デジタルLCRメータモデル4275Aを使用 し、砂定温度20℃、耐定電圧1.0Vrms、 砂定周波数1M比による砂定で求めた。なお、温 度係数は20℃における容量値を基準とし、次式 より求めた。

温度係数 = (C 85 ℃ - C 20 ℃) / (C 20 ℃ × 6 5) × 1 O ⁶ (p p m / ℃)

また、絶縁抵抗はYHP社製HRメークモデル 4329Aを使用し、調定電圧D. C. 50V、制定時間1分間による測定で求めた。さらに、絶縁破壊電圧は菊水電子工業側高電圧電源PHS35K-3形を使用し、昇圧速度50V/secにより求めた絶縁破壊電圧を素子厚みで除算し、単位長さ当たりの絶縁破壊電圧値とした。試験条件及び結果を第1表に併せて示す。

(以下 余白)

														_	
		(k v/=)	31.8	32.8	32.8	34.8	35.0	35.1	35.3	34.5	32.8	32.6	32.2	32.9	
	1 5	数 (2)	3.0×1012	8.0×10"	3.0×101	7.0×1011	8.0×10'	1.1×10 ¹¹	1.0×10 ¹³	1.0×10 ¹³	5.0×10tf	2.0×101	1.0×10"	3.0×101	
	以	田田市 (500円)	N970	N1062	N1168	N1369	N1070	1698	N1136	N942	N1305	N1300	N1150	N1200	
人		BURG	2000	1300	1400	3300	3700	5400	2200	4800	2700	2200	1800	2000	
# # ·		* *	202	165	172	225	193	210	206	205	117	180	081	180	
٧	熱布温度	9	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	
	主统外2对 する副位分	V ₁ O ₁ 量 (減量%)	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	IL)	2	0.520	0.528	0.539	0.306	0.520	0.510	0.510	0.520	0.525	8.491	0.500	0.510	
	主成分(モル)	y	0.339	0.150	0.171	0.24 M	0.130	9.13	0.180	6.0	0.186	0.18	0.181	0.161	
	##	×	0.271	0.273	0.230	(<u>23</u>	0.230	0.30	0.310	0.300	0.38	0.310	0.313	0.333	
	Ħ	中	-	2	6	7	5	0	~	8	۵	0	=	12	

(実施例2)

出発原料には化学的に高純度のSrCO」、CaCO」、TiO2、V2Os、MnO2、Cr2O」、FeO、NiO、CoO及びSiO2粉末を下記の第2表に示す組成になるように秤量し、それ以降は実施例1の場合と同様に処理して第2表に示す配合組成の誘電体磁器を得た。

これらの試料の試験方法は実施例1と同一であり、試験条件及び結果を第2表に併せて示す。

(以下 余白)

				_	•—					
へ 衛	\$\$; \$1	化配质器 E(kv/m)	35.1	35.3	35.0	34.4	33.0	33.2	33.7	35.4
		(S)	1.01×0.1	1.3×10 ¹¹	1.5×1014	2.0×1011	1.5×1014	2.0×1011	3.0×1013	2.0×101ª
	坂	温度系数 (ppm/C)	N680	N690	N680	N766	N817	N838	N865	N715
		BUFFEG	5800	2600	2900	2100	0065	2900	5200	5200
		#E	213	208	204	193	187	166	151	210
	報題	8	1370	1383	1380	1340	0 1 81		333	
報 2 集 >	主成分に対する数	0.05	0.10	0.20	0.40	0.60	08.0	1.00 130	0.20	
	を対す		MnO	₹ОиЖ	MnO	CrrOs	FeO	Nio	0°3	\$10
	主成分に対する異	成3 1章 (項量%)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	主成分(モル)	2	0.5.0	0.510	0.510	0.510	0.510	0.510	0.510	0.510
		у	0.130	0.190	0.130	0.130	0.150	0.13	0.130	0.190
	#1	×	0.30	0.300	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	#	味	13	14	15	16	17	18	19	20

特問平3-53407(4)

なお、これらの実施例における誘電体数器組成物の製造方法では、SrCO1,CaCO1,TiO1. V2O5を使用したが、この方法に限定されるものではなく、所望の組成比になるように、

SrTiO1, CaTiO1などの化合物を使用し 製造しても実施例と同程度の特性を得ることができる。

また、実施例2において、MnO2、Cr2O1、FeO、NiO、CoO及びSiO2を使用し製造したが、この方法に限定されるものではなく、Mn(CO1)1、Mn(OH)4などの炭酸塩、水酸化物を使用して製造しても実施例と同程度の特性を得ることができる。

発明の効果

以上のように本発明によれば、誘電率、絶縁抵抗及び絶縁破壊電圧が高く、良好度Qにすぐれ、かつ温度保数の小さい誘電体磁器を得ることができる。

また、マンガン,クロム,鉄,ニッケル, コパルト及びケイ素の酸化物の添加により、鏡成温度

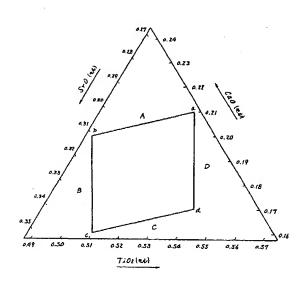
を低下させることかできる。

さらに、得られた誘電体磁器は高誘電率であるため、 案体をきわめて小形にすることができ、 回路の微小化に有効であり、特に薄板状にして低層セラミックコンデンサ、ハイブリッド微小回路などの用途に適している。

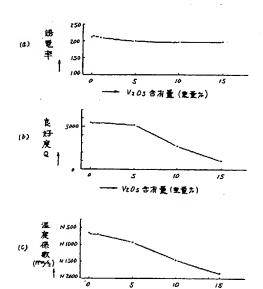
4、図面の簡単な説明

代理人の氏名 弁理士 栗野道孝 ほか1名

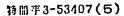
3K 1 🖾



22 9 f2π



V205 含有量(登量次)



第 2 図

